

Rys. 1-1351. KT602

**Typ tranzystora:** tranzystor krzemowy

**Firma:** ZSRR

**Wykonanie:** tranzystor krzemowy dyfuzyjny *n-p-n* średniej mocy w.cz., w hermetycznej obudowie metalowej

**Zastosowanie:** układy generacyjne i wzmacniające w urządzeniach powszechnego użytku

**Typy podobne:** BF108, BSY55, BSY56, BSY87/88

#### Wartości charakterystyczne<sup>1)</sup>

	KT602A	KT602B	KT602B	KT602Γ		
$I_{CBO}$			70	70	μA	przy $U_C = 80$ V
$I_{CB0}$	70	70			μA	przy $U_C = 120$ V
$I_{CER}$			100	100	μA	przy $R_{BE} = 10 \Omega$ , $U_C = 70$ V
$I_{CER}$	100	100			μA	przy $R_{BE} = 10 \Omega$ , $U_C = 100$ V
$U_{CB0}$	120	120	80	80	V	przy $t_j \leq 70^\circ\text{C}$
$U_{CEsat}$	3	3	3	3	V	przy $I_C = 50$ mA, $I_B = 5$ mA
$U_{EBsat}$	3	3	3	3	V	przy $I_C = 50$ mA, $I_B = 5$ mA
$C_c$	4	4	4	4	pF	przy $U_C = 50$ V, $f = 2$ MHz
$C_e$	25	25	25	25	pF	przy $U_E = 0$ , $f = 2$ MHz
$r_{b'b} C_c$	300	300	300	300	ps	przy $U_C = 10$ V, $I_C = 10$ mA, $f = 2$ MHz
$f_T$	150	150	150	150	MHz	przy $U_C = 10$ V, $I_C = 25$ mA, $f = 100$ MHz
$h_{21E}$	20÷80	≥50	15÷80	≥50		przy $U_C = 10$ V, $I_E = 10$ mA

#### Wartości graniczne

	75	75	75	75						
$I_C$ max	75	75	75	75	mA	$U_{EBO}$ max <sup>4)</sup>	5	5	5	V
$I_{CM}$ max	500	500	500	500	mA	$P_{tot}$ max <sup>5)</sup>	2,8	2,8	2,8	W
$I_E$ max	80	80	80	80	mA	$R_{th j-a}$ max	5	5	5	°C/W
$U_{CER}$ max <sup>2)</sup>	100	100	70	70	V	$t_j$ max	120	120	120	°C
$U_{CER}$ max <sup>3)</sup>	50	50	35	35	V	$t_{amb}$	-40÷	+85		°C

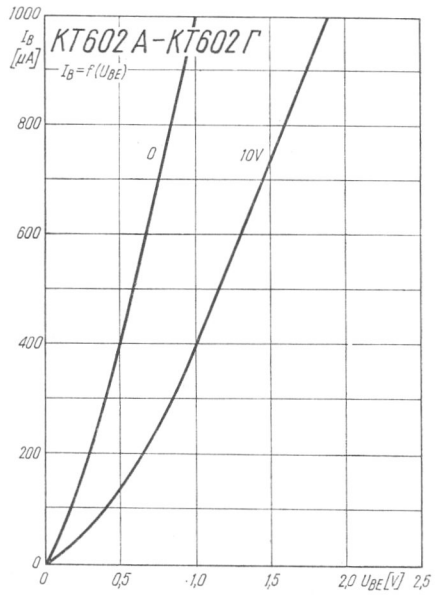
<sup>1)</sup>  $t_{amb} = 20^\circ\text{C} (\pm 5^\circ)$

<sup>2)</sup>  $R_B \leq 1 \text{ k}\Omega$ ,  $t_j \leq 70^\circ\text{C}$

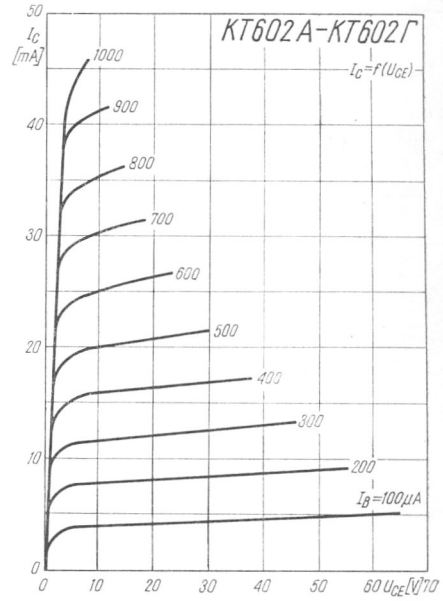
<sup>3)</sup>  $R_B \leq 1 \text{ k}\Omega$ ,  $t_j = 120^\circ\text{C}$

<sup>4)</sup>  $-40^\circ\text{C} \leq t_j \leq +120^\circ\text{C}$

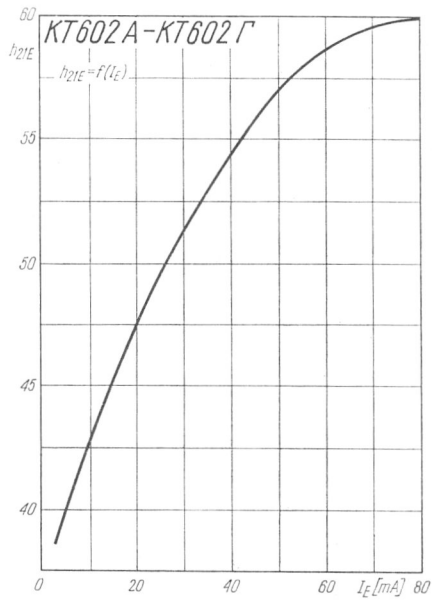
<sup>5)</sup> z dodatkowym chłodzeniem,  $t_{case} \leq 20^\circ\text{C}$



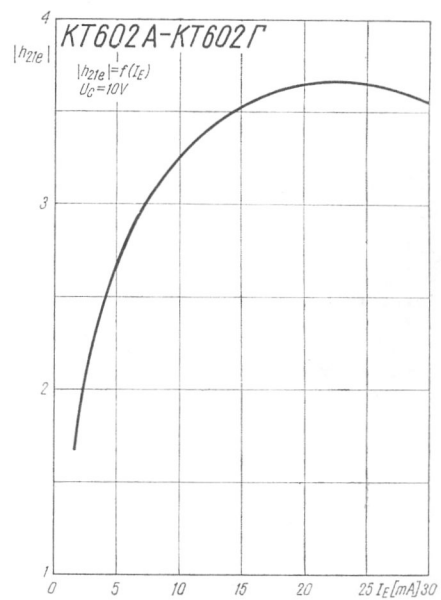
Rys. 1-1352. Charakterystyki wejściowe



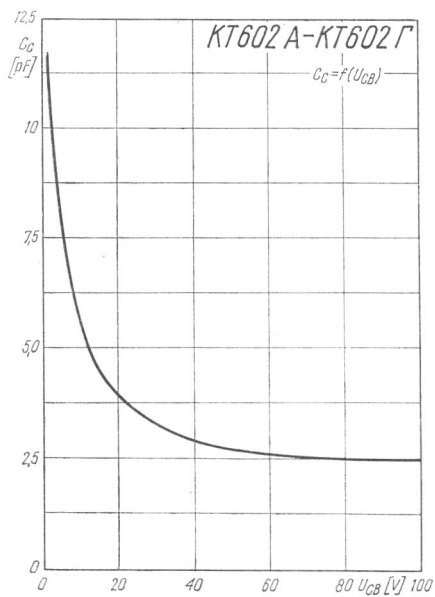
Rys. 1-1353. Charakterystyki wyjściowe



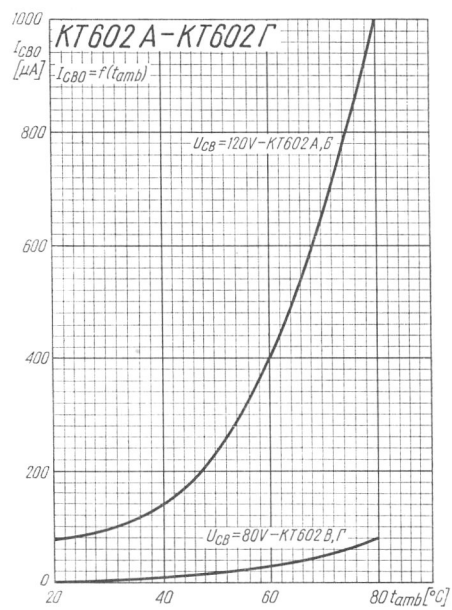
Rys. 1-1354. Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu emitera



Rys. 1-1355. Zależność modułu współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu emitera



Rys. 1-1356. Zależność pojemności kolektora od napięcia kolektor-baza



Rys. 1-1357. Zależność prądu zerowego kolektora od temperatury otoczenia